発光分光計測による電子エネルギー分布関数診断にむけた 低気圧マイクロ波放電アルゴンプラズマの励起状態分布の解析

The excited-state distribution analysis of the low-pressure microwave discharge argon plasma

for electron energy distribution function diagnosis by optical emission spectroscopic measurement

都立産業技術研究センター¹, 東工大研究院² ⁰山下 雄也¹, 赤塚 洋²

TIRI¹, Tokyo Tech², ^oYuya Yamashita¹, Hiroshi Akatsuka²

E-mail: yamashita.yuya@iri-tokyo.jp

1.はじめに

電子エネルギー分布関数(EEDF)の発光分光 計測(OES)による診断の実現が求められている. 本研究では低温非平衡プラズマにおいて, EEDF が励起状態分布におよぼす影響を解析し, OES による診断にむけた検討を行ったので報告する.

2. Langmuir プローブによる EEDF 測定

発振周波数 2.45 GHz, 圧力 p = 133Pa, 放電管 半径 r = 13mm のマイクロ波放電アルゴン表面 波プラズマを対象に, 非対称 Langmuir ダブルプ ローブ計測を行い Druyvesteyn 法[1]により Fig.1 (A)に示す EEDF を得た[2]. これより等価な電子 温度 $T_e = 2\langle \epsilon \rangle/3k_B = 5.06$ eV, 電子密度 $N_e=3.45$ ×10¹⁰ cm⁻³と算出された. なお図ではEEDF $F(\epsilon)$ を, $2\pi(2k_B T_e/m_e)^{3/2} \int \sqrt{u} f(u) du = 1$ (ただし $u = \epsilon/k_B T_e$) で規格化[3]した電子エネルギー確 率関数 (EEPF) $f(\epsilon) = F(\epsilon)/\sqrt{\epsilon}$ で示した.

3. 衝突輻射モデルに基づく励起状態分布解析

アルゴン衝突輻射(CR)モデル[3]は T_e , N_e , 原 子温度 T_a , イオン密度 N_i , r, p および EEDF を入 力として, 励起状態数密度 n_i 分布を求める原子 過程モデルである. ただし i は準位番号[3]であ る. $T_a = 500$ K, $N_l = N_e$ と仮定した. T_e および N_e は上記 2.の結果を用いた. EEDF は(A)上記 2.の 実測値, (A)に等しい T_e , N_e を有する(B) Maxwell 分布および(C) Druyvesteyn 分布を仮定し, CR モ デルにより reduced population density n_i/g_i を求 めた (Fig. 2). n_i/g_i の標準偏差 $\sigma(n_i/g_i)$ により 定義される EEDF に対する変動係数(coefficient of variation): $C_v(n_i/g_i) = \sigma(n_i/g_i)/(\overline{n_i/g_i})$ を求 めたところ Fig. 2 のとおりとなった.

4. 考察

 $C_v(n_i/g_i)$ の準位依存性の結果から、準位 (3d'[3/2] $^{\circ}_{2^+}$ [5/2] $^{\circ}_{2,3}$)-16s',p',d',f'...(Racah 記号) において、EEDF の違いによる n_i/g_i のばらつき



Fig. 2 The EEDF dependence of the exited-state distribution

が大きいことがわかる. これらの準位を用いる ことで EEDF 診断が行える可能性がある. なお, $C_v(n_i/g_i)$ が最も大きい 3d'[3/2] $^{\circ}_1$ と次いで大き い 6s'[1/2] $^{\circ}_1$ はともに OES で n_i が直接計測可能 な準位である. しかしながら OES で直接計測で きない n_i もあるので,定量的な EEDF 診断のた めには,多数本の発光線スペクトル強度を取得 して CR モデルに基づいて逆算[2]する必要があ る. EEDF を未知変数パラメータ[4]とする診断 モデルの体系的な解明が課題である.

参考文献

- [1] M.J. Druyvesteyn, Z. Phys. 64, 781 (1930).
- [2] Y. Yamashita et al., Jpn. J. Appl. Phys. 58, 016004 (2019).
- [3] J. Vlček, J. Phys. D:Appl. Phys. 22, 623 (1989).
- [4] R. Kashiwazaki et al., Jpn. J. Appl. Phys. 41, 5432 (2002).